



中国科学院半导体研究所
Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

半导体之声

BAN DAO TI ZHI SHENG

2019年2月 总第119期

目 录

特别关注

半导体所“集成化宽频带光发射器件与模块”项目荣获国家技术发明二等奖

新闻纵览

半导体所召开2018年度党员领导干部专题民主生活会

王占国院士从事科研工作60周年学术交流会暨先进半导体材料与器件前沿进展研讨会隆重举行

JOS 2018年编委大会成功召开

半导体所召开2018年度领导班子、党建工作述职考评会暨工作报告会

半导体所召开所务会研究贯彻落实2019年度院工作会议精神

半导体所领导走访慰问老党员、老干部和生活困难职工

交流合作

北京市科委许强主任一行来访半导体所

澳大利亚昆士兰大学电镜专家邹进教授来我所进行学术交流

李永舫院士来半导体所交流

美国德克萨斯大学奥斯汀分校Xiaoqin (Elaine) LI教授来半导体所交流

获奖喜讯

半导体所授权专利“低发散角近衍射极限输出啁啾光子晶体边发射激光器阵列”荣获第二十届中国专利金奖

半导体所姜正副研究员入选第四届“青年人才托举工程”

党建之窗

半导体所召开2018年第五次党委中心组学习扩大会

半导体所各党支部集中组织党建述职考评、组织生活会和民主评议党员工作

半导体所举办科技体制改革与“放管服”政策讲座

创新文化

半导体所举行离退休新春团拜会

2019半导体所元旦晚会圆满落幕

半导体所2018-2019学年度留学生交流会圆满结束

半导体所召开2018年度群团工作总结交流会

半导体所“集成化宽频带光发射器件与模块”项目 荣获国家技术发明二等奖



2019年1月8日，中共中央、国务院在北京人民大会堂隆重举行国家科学技术奖励大会，对为我国科学技术进步、经济社会发展、国防现代化建设作出突出贡献的科学技术人员和组织给予奖励。

半导体所牵头申报的项目“集成化宽频带光发射器件与模块”荣获国家技术发明二等奖。项目主要完成人：祝宁华，刘建国，陈向飞，马卫东，刘宇，陈伟。该项目是中国科学院半导体研究所、南京大学和武汉光迅科技股份有限公司三家单位通过多年合作完成的研究开发成果，联合承担了国内第一批光电子集成器件的重点研究项目，解决了集成化激光器模块在研究开发过程中面临的核心技术问题。研究成果受到国内外同行的广泛关注，与华为公司合作开发了我国首款实用化4×25G多波长激光器模块。基于专利技术研发的集成光收发模块用于华为、中兴、烽火、谷歌、阿朗等国内外知名公司系统设备中，并在国家多项高技术项目中获得了应用，为实现核心高端光电子集成器件的自主可控提供了保障。

据悉，国家科学技术奖励每年评审一次，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖“三大奖”，此外，还包括授予外籍科学家或外国组织的中华人民共和国国际科学技术合作奖，以及分量最重的国家最高科学技术奖。根据2017年5月最新发布的《关于深化科技奖励制度改革方案》的有关规定，三大奖每年授奖总数不超过300项。

半导体所召开2018年度党员领导干部专题民主生活会

1月31日上午，半导体所召开2018年度党员领导干部专题民主生活会。中科院副院长、党组成员李树深，北京分院分党组书记、副院长、京区事业单位党委书记马扬，北京分院干部人事处业务主管刘爽到会指导。党委书记、副所长冯仁国主持会议，副所长（法定代表人）、党委委员祝宁华，党委副书记、纪委书记樊志军，副所长、党委委员谭平恒参加会议，无党派人士、副所长杨富华以及党办负责同志列席会议。

会上，樊志军首先通报了2017年度民主生活会整改措施及落实情况和本次民主生活会征求意见、谈心谈话情况。

冯仁国代表领导班子通报了领导班子对照检查材料。班子成员紧密围绕“强化创新理论武装，树牢‘四个意识’，坚定‘四个自信’，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处”的会议主题，立足找准问题、解决问题，重点从思想政治、精神状态、工作作风等3个方面查找自身存在的差距和不足，进行深入的党性分析，报告了2017年度民主生活会整改措施落实情况，严肃认真地开展了批评和自我批评，并围绕战略思维能力、人才建设、强化学习效果等方面，互相提出了建设性的意见和建议。每位班子成员均表态虚心接受批评，认真落实整改。班子成员之间交流思想，坦诚相见，营造了团结、和谐、真诚、务实的会议氛围。

李树深对2018年半导体所取得的一系列成绩的给予充分肯定，并希望半导体所领导班子在院党组、北京分院分党组的领导下，2019年继续稳步前行，围绕“四个率先”进行积极谋划，为国民经济发展和国家重大需求做出重要贡献。

马扬在点评讲话中谈到，半导体所本次民主生活会有效、成功、规范。下一步半导体所要按照李院长提出的要求，进一步保持现有优势，在人才战略、学科建设等方面加强对研究所未来发展的顶层谋划；进一步加强领导班子建设，强化党委中心组学习，加强交流，形成共识，发挥班子成员的特长优势，形成合力做大事；进一步加强人才队伍建设，加大人才引进和培养力度，为半导体所的长远发展提前布局；进一步集成优势产出重大成果，前沿领域做得更尖更专，应用领域做得更大更强。

最后，冯仁国代表班子成员作了表态发言，他感谢院党组、北京分院分党组各位领导的支持，下一步将按照院党组、北京分院分党组的要求，把党建工作做好，为半导体材料与光电子器件科教融合卓越中心建设提供坚强的思想、政治和组织保障。



王占国院士从事科研工作60周年学术交流会 暨先进半导体材料与器件前沿进展研讨会隆重举行



共聚一堂忆峥嵘，继往开来铸辉煌。12月29日，为了回顾王占国院士60年的学术生涯，为了研讨先进半导体材料与器件的前沿进展，学习王占国院士占“新”为民、兴“材”报国的崇高品格和孜孜以求、勇于创新的精神，感受他谦逊正直、提携后生的大家风范，在这个阳光灿烂、碧空万里的日子里，隆重举行王占国院士从事科研工作60周年暨先进半导体材料与器件前沿进展研讨会。

中科院副院长、中国科学院大学党委书记、校长李树深院士，北京大学秦国刚院士，半导体所王圩院士，微电子所刘明院士，厦门大学校长、党委副书记张荣教授，东北师范大学校长、党委副书记刘益春教授，南昌大学党委常委、副校长江风益教授，半导体所副所长（法定代表人）祝宁华，党委书记、副所长冯仁国，副所长杨富华，党委副书记、纪委书记樊志军，副所长谭平恒，所长助理张韵、李明，中山大学电子与信息工程学院院长邓少芝教授，北京大学沈波教授，同济大学化学科学与工程学院院长张驰教授，南开大学泰达应用物理研究院副院长孔勇发教授以及王占国院士的同事、朋友与学生代表等200余人参加了此次会议。会议由半导体所材料科学重点实验室主任王智杰主持。

六十年开拓创新，硕果累累；六十年辛勤耕耘，人才济济。上午九时许，王占国院士从事科研工作60周年暨先进半导体材料与器件前沿进展研讨会正式拉开帷幕。

首先，中科院学部工作局副局长苏荣辉宣读中国科学院院长、党组书记、学部主席团执行主席白春礼院长贺信。白春礼在贺信中高度评价了王占国院士为我国半导体材料和材料物理研究方面做出的系统性和创新性的突出贡献，坚持不懈、锐意进取的科学精神和爱国奉献、平易近人的优秀品质，以及为学部发展、国家科学思想库建设和在青年科技人才培养方面取得的突出成绩，向王占国院士致以衷心的祝贺和诚挚的问候。

随后，中科院副院长、中国科学院大学党委书记、校长李树深院士讲话。他谈到，近60年来，王占国院士在半导体材料科学研究等方面取得了一系列重大成果，为国家半导体科技事业的发展做出了突出贡献；王占国院士心系国家和半导体所的发展，为我国科技事业和半导体所的发展建言献策；王占国院士以教育为己任，甘为人梯、提携后进，为国家培养和造就了一大批优秀科技人才。他还回顾了自己1993年作为博士生进入半导体所时，王占国院士对他的深切教诲，指出王占国院士坚持真理的科学精神、报效祖国的爱国情操和淡泊名利的崇高品格为我们树立了楷模，是我们晚辈后学的宝贵财富。

接下来，半导体所副所长（法定代表人）祝宁华致辞。他代表半导体所向王院士致以崇高的敬意和美好的祝愿，并向前来参加活动的各位领导和来宾表示热烈的欢迎和诚挚的问候。他谈到，近60年来，王院士以强烈的事业心、责任感、使命感，为我国半导体材料学科建设和技术创新做出了杰出贡献，而且毫无保留的将自己的学识、经验、成果奉献、传授给年轻一代，为推进人才培养做出了卓越贡献。在此祝福王院士的学术之树常青，生命之水长流。

王占国院士的同事、朋友、学生等纷纷进行了发言，回顾了王占国院士的学习生活和工作经历，介绍了王占国院士的学术成就与科研贡献，回忆了与王占国院士在一起的美好时光，赞叹王占国院士的爱国奉献、谦虚正直的优秀品质，感谢王占国院士多年来对青年学子的关怀提携，感谢王占国院士对半导体材料科学事业的大力支持，大家共同祝愿王占国院士身体健康，科技之树常青。

王智杰简要介绍了半导体所材料科学重点实验室的情况和发展状况。他谈到，实验室经过30多年的努力，薪火传承，继往开来，一步一个坚实的脚印，在低维半导体光电子材料、器件与集成、高温及高迁移率微电子材料与器件和单晶衬底及特殊环境半导体材料等方面取得了长足的发展。

王占国院士在答谢讲话中指出，感谢大家在百忙之中前来参加此次会议，感谢与他一同并肩战斗的同事们。他指出，在大家的努力下，材料科学重点实验室历经30年的发展，在半导体低维结构和量子器件研究、用于光通信的DFB激光器和电吸收器调制器研究等方面取得了国内领先、国际先进水平的成绩，但与国家重点实验室的需求还有一定差距。他希望实验室提高科研水平，引进领军人才，为国家和研究所作出更大的贡献，为中华民族伟大复兴贡献力量。王占国还谈到自己在科研方面的体会：一是作为科技工作者要实事求是、坚持真理；二是不盲从权威，敢于挑战科学难题；三是要有不耻下问、打破砂锅问到底的精神。

下午，刘会赞、陆沅、张子旸、丛光伟、廖梅勇、卓宁、赵超分别作了学术报告，就先进半导体材料与器件的前沿进展发表了各自的学术观点。



王占国院士致答谢词



中科院副院长、中国科学院大学党委书记、校长李树深讲话



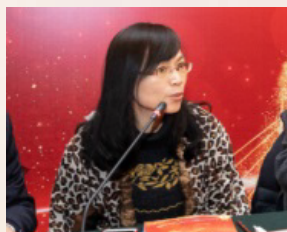
中科院学部工作局副局长苏荣辉宣读中国科学院院长、党组书记、学部主席团执行主席白春礼院长贺信



北京大学秦刚院士发言



半导体所王圻院士发言



微电子所刘明院士发言



半导体所副所长（法定代表人）祝宁华致辞



半导体所党委书记、副所长冯仁国发言



合影

JOS 2018年编委大会成功召开

2018年11月17日下午, Journal of Semiconductors 2018年编委大会在北京成功召开。李树深主编、李明常务副主编以及64位编委参加了此次大会。另外, 科睿唯安业务总监宁笔、中科院长春光机所Light常务副主编白雨虹也应邀出席了此次大会。

会议由李树深主编主持。李主编首先热烈欢迎与会的编委和领导, 感谢他们一直以来对学报的支持与帮助; 然后介绍了新任常务副主编李明研究员, 希望在常务副主编李明的带领下, 编委的支持和配合下, 积极推动JOS的发展。

编辑部副主任金瑞琴汇报了JOS工作情况。随后宁笔先生做了“中国创建世界一流期刊的若干思考”的精彩报告, 以数据分析并结合JOS实际情况, 对JOS的发展提出了多项建议。白雨虹女士详细介绍了Light办刊经验和编委会运作情况, 为今后JOS编委及编辑部工作提供了重要借鉴经验。

李明做了“JOS的历史、现在与未来”的报告, 回顾了JOS自创刊以来取得的荣誉、进步, 指出了目前存在的主要问题, 并提出了针对性的解决方案: (1) 建立高标准, 发表“标杆性”论文; (2) 建立半导体所内学报发展推进工作组, 负责联系副主编; (3) 设立“快速通道”, 优秀稿件快速审稿和发表; (4) 明确编委的责权利, 加强动态调整, 提升责任感与荣誉感; (5) 依托编委会, 提升稿源、审稿及宣传的国际化; (6) 实现所有稿件宣传的全覆盖, 科普化宣传, 以及后期跟踪; (7) 稿件分类专业化, 明确10个发文方向; (8) 借鉴高端期刊模式, 丰富栏目类型; (9) 2019年开始与编委会大会同期召开JOS Conference。

与会编委按照发文方向分组以“获得优质稿源、提升期刊影响力”为主题进行了热烈探讨, 明确了各组的约稿计划、专刊计划、宣传计划及新栏目的工作计划。

李主编总结发言, 明确期刊“先做强、再做大”的发展计划, 降低零引用文章比例; 各发文方向的发文数量根据实际情况可以进行微调; 编辑部提供一个平台, 作者可自愿将文章放在平台上, 经过审稿但不能在期刊正式发表的文章也可以放在平台上。

编辑部根据2018年的工作情况, 评选出优秀审稿人奖、优秀论文奖、优秀编委奖和突出贡献奖, 其中优秀审稿人奖是2018年首次设立, 李主编亲自为获奖编委颁发证书, 为新任编委颁发聘书!

编辑部将认真梳理落实编委们提出的意见和建议, 全力支持、配合编委会工作, 为提升学报质量和水平继续努力!



半导体所召开2018年度领导班子、党建工作 述职考评会暨工作报告会

2019年1月22日，半导体所在学术会议中心召开了2018年度领导班子、党建工作述职考评会议暨工作报告会。半导体所王启明院士、王占国院士、陈良惠院士、夏建白院士、领导班子成员、党委委员、纪委委员、学术委员会委员、职代会常设主席团成员、中层领导人员（包括正副处长）、实验室正副主任、正高级专业技术人员和各类职工代表以及北京分院党建工作处工作人员吉顺等200余人参加了会议。

首先，召开了领导班子和党建工作述职考评会议。会议由半导体所党委书记、副所长冯仁国主持。

半导体所副所长（法定代表人）祝宁华代表所领导班子作了领导班子述职报告。他主要从“一三五”规划进展、人才队伍建设、财务收支情况、党建工作和纪检工作、离退休工作、基建园区建设等方面简要介绍了半导体所2018年各项工作的整体进展情况，全面回顾了研究所在2018年度取得的成绩和存在的不足，并对2019年重点工作进行了部署。

随后，召开了2018年度工作报告会。会议由半导体所工会主席、职代会常设主席团主席王军喜主持。

实验室(中心)负责人就2018年度工作进行汇报，同时对2019年的工作进行了展望和规划，提出了具体的工作思路。各实验室(中心)分别从承担科研项目、人才队伍建设、科研成果、发表论文和专利情况以及2019年主要工作计划等方面进行汇报。

下午，机关各部门负责人分别从本年度工作情况以及下一年工作设想等方面进行了简要汇报，半导体所引进人才分别进行工作汇报，研究所投资管理委员会对参股公司的经营情况进行了简要汇报。

最后，与会人员填写了《领导人员年度考核测评表》、《领导人员年度考核测评表》、《半导体研究所党委工作考评民主测评表》、《半导体研究所党委班子履职情况民主测评表》、《实验室和机关职能部门负责人年终考核评议票》、《2018年引进人才年终考核评议票》。



半导体所副所长(法定代表人)祝宁华作报告



半导体所党委书记、副所长冯仁国主持考评会



会场

半导体所召开所务会研究贯彻落实2019年度院工作会议精神



2019年1月17日至18日上午，中科院召开了2019年度工作会议，半导体所副所长、法定代表人祝宁华、党委书记冯仁国参加了会议。1月18日下午，半导体所召开所务会，学习传达中科院2019年度工作会议精神。会议由祝宁华主持，所领导、所长助理参加会议。

会上，祝宁华传达了白春礼院长作的题为《改革开放再出发 攻坚克难攀高峰 奋力决胜基本实现“四个率先”目标》的工作报告，对报告内容进行了解读。祝宁华还结合自身的学习思考 and 体会对贯彻落实会议精神做出具体部署，对所务会成员提出明确

要求：务必高度重视，增强责任感，将全所发展思想认识统一到报告中的“六个根本转变”上来；务必深化研究所改革，加大力度，细化措施，结合研究所实际，切实推进实现2019年研究所重点工作任务。

与会人员从研究所科研战略布局、创新人才队伍建设、学科领域与区域科研机构统筹规划布局等各个方面提出问题及改革建议，表示将结合自己分管的工作，深入思考并进一步明确中心工作和重点任务，制定2019年度改革方案和工作目标。

祝宁华强调指出，此次院工作会内容丰富、信息量大，要全面、系统、深度领会院工作会议的重点精神和关键信息，所务会成员要带头学习理解和贯彻落实，抓住机遇，创造条件，着力推动全所各项工作，为半导体所创新发展做出更大贡献。

半导体所领导走访慰问老党员、老干部和生活困难职工



2019年是新中国成立70周年，是我院建院70周年。在元旦、春节期间走访慰问老党员、老干部和生活困难职工，让党员干部和职工群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，具有十分重要的意义。为使半导体所职工和离退休老同志们过上一个欢乐、祥和、安定的新春佳节，春节前夕，半导体所领导分别进行了走访慰问，为他们送去温暖和节日的祝福。

在老党员和老干部的家中，所领导和他们亲切交谈，关切询问身体状况、生活情况，介绍研究所的新发展、新变化，感谢老干部、老党员为研究所发展作出的贡献，希望他们保重身体、健康长寿、开心快乐，在安享晚年的同时继续为研究所改革发展建言献策，发挥余热。

在慰问生活困难职工时，所领导详细询问了解了他们的生活情况和实际困难，鼓励他们调整心态，树立信心，勇于面对困难，早日走出困境。

此次春节前夕走访慰问活动，切实把研究所的关怀送到老党员、老干部和生活困难职工身边，让他们寒冬不寒、温暖在心。



北京市科委许强主任一行来访半导体所

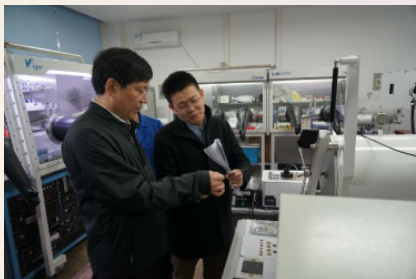
2019年1月3日上午，北京市科委许强主任一行7人访问半导体所。

首先，许强主任一行参观了半导体材料国家重点实验室光电磁功能薄膜与空间晶体研究组了解钙钛矿太阳能电池最新研究进展，有机无机杂化钙钛矿材料具有优异和独特的光电性能，近年来发展迅速，游经碧研究员团队经过不懈努力已实现23.7%的太阳能电池效率，连续两次创造钙钛矿电池转换效率的世界纪录；占据了中国在光伏领域的五个世界纪录中的两个。

同时参观了集成光电子学国家重点实验室GaN基光电子材料与器件研究组，赵德刚研究员团队实现国内第一只GaN紫外激光器，其中382 nm 激光器室温电注入连续激射，阈值电流密度2.8 kA/cm²，输出功率60mW。

随后许强主任一行与半导体所副所长（法定代表人）祝宁华，副所长杨富华、谭平恒，所长助理张韵、李明及相关科研人员进行了座谈交流。

祝宁华代表半导体所对许强主任一行的到来表示热烈欢迎，并就北京市科委一直以来对半导体所的支持表示感谢。许强主任肯定了半导体所在光电子领域突出的科研进展，解决了“卡脖子”问题，表示科委会持续关注与支持，也希望半导体所的科研成果能更好的服务于北京建设全国科技创新中心。



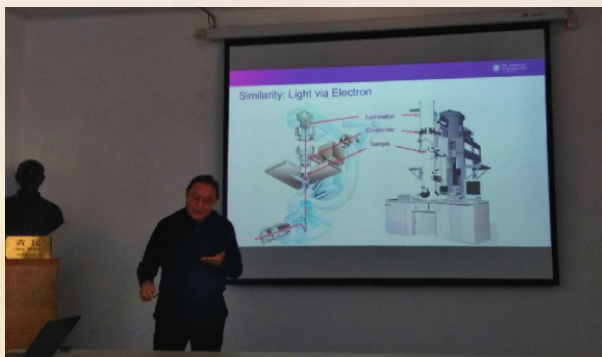
澳大利亚昆士兰大学电镜专家邹进教授来我所进行学术交流

应我所超晶格室赵建华研究员邀请，2月16日上午，澳大利亚昆士兰大学电子显微中心与材料系纳米科学讲席教授、澳大利亚电子显微学会秘书长邹进教授来我所进行学术交流，并为我所60多名老师和研究生作了题目为“透射电镜的结构、原理及应用”精彩生动的报告。

邹进教授从透射电镜的结构开始，详细地讲解了透射电镜各部分的组成、工作机制及成像原理，介绍了透射电镜的成像模式包括明暗场像等。此外，讲授了与透射电镜结合的X射线能量色散谱及电子能量损失谱在纳米尺度下对样品进行结构及成分分析的相关知识。最后，结合电子显微学的最新发展趋势，他还介绍了高分辨扫描透射电子显微方法和相关成像技术。

本次报告虽然只有2个多小时，但邹进教授由浅入深，详细清晰地讲解了透射电镜的相关知识，介绍了目前国际最前沿的电子显微学研究成果，指出了衍射学和显微学方法的未来发展趋势。在问答环节中，邹教授与在场师生积极互动，耐心细致地为在场师生进行了答疑解惑，讨论交流，使大家受益匪浅。

超晶格室于2017从日本电子株式会社购置了一台冷场发射高分辨透射电子显微镜(JEM F200)，该设备已到货并安装完毕，目前正在进行调试，邹进教授的报告为2019年4月正式启用该设备进行了很好的热身。



李永舫院士来半导体所交流



应半导体所材料重点实验室张兴旺研究员，游经碧研究员的邀请，2019年1月18日上午，中国科学院化学研究所、苏州大学的李永舫院士来半导体所进行学术交流，并在“黄昆半导体科学技术论坛”上作第335期报告。

交流会上，李永舫院士作了题为“天道酬勤—我的人生和科研感悟兼谈聚合物太阳能电池光伏材料最新进展”的学术报告，院士用自己的人生经历向大家道出科研路上需要砥砺前行，阐述了“热爱+用心+努力+认真=成功”的人生感悟，同时系统地介绍了聚合物太阳能电池光伏材料的

最新进展，对进一步提高聚合物太阳能电池效率进行了精辟的阐述，发表了自己独到的见解。并与在座的50余名博士和硕士研究生进行了热烈的讨论和交流，使大家受益匪浅。张兴旺研究员主持了报告会。

美国德克萨斯大学奥斯汀分校Xiaoqin (Elaine) LI教授来半导体所交流



应半导体所超晶格实验室谭平恒研究员的邀请，2018年12月28日下午，来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校（University of Texas–Austin, USA）的Xiaoqin (Elaine) LI教授来半导体所进行学术交流，并在“黄昆半导体科学技术论坛”上作第327期报告。

交流会上，Xiaoqin (Elaine) LI教授作了题为“Van der Waals Semiconductor Monolayers and Heterostructures as New Photonic Materials”的学术报告，系统地介绍了她的研究组最近在单层范德华半导体材料及其组成的异质结构中的激子性质的研究进展，并对限制在垂直异质结moiré势中的层间激子和利用超表面控制谷偏振激子发表了独到的见解，与在座的40余名博士和硕士研究生进行了热烈的讨论和交流，使大家受益匪浅。

此外，半导体所谭平恒研究员、张俊研究员、张新惠研究员等与Xiaoqin (Elaine) LI教授进行了更深入的交流和讨论，感谢她在百忙之中来半导体所作学术报告并进行学术交流，希望双方能进一步加强合作，不断促进我所与美国德克萨斯大学奥斯汀分校的友好合作关系。

半导体所授权专利“低发散角近衍射极限输出啁啾光子晶体边发射激光器阵列”荣获第二届中国专利金奖

12月25日，第二届中国专利奖颁奖大会在北京隆重召开，半导体研究所郑婉华课题组授权专利“低发散角近衍射极限输出啁啾光子晶体边发射激光器阵列”荣获第二届中国专利金奖，这是我所首次荣获中国专利金奖。

“低发散角近衍射极限输出啁啾光子晶体边发射激光器阵列”专利是基于半导体光子晶体激光芯片，通过在传统半导体激光外延中引入垂直方向和水平方向的啁啾光子晶体结构，在保证激光高输出效率的同时，有效解决了传统半导体激光芯片发散角大，亮度低等共性问题，该发明与传统光电子芯片制备技术相兼容，适合于广泛推广。获奖专利技术采用人工微结构功能材料，属未来高端半导体激光芯片发展的新方向，为我国突破高端激光芯片壁垒提供了自主制造新方案。

据悉，“中国专利奖”由国家知识产权局于1989年设立，每年评选一次，是中国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，得到联合国世界知识产权组织(WIPO)的认可，在国际上有一定的影响。第二届中国专利奖共评选出中国专利金奖30项，中国外观设计金奖10项，中国专利银奖60项，中国外观设计银奖15项，中国专利优秀奖预获奖项目698项，中国外观设计优秀奖预获奖项目61项。



半导体所娄正副研究员入选第四届“青年人才托举工程”

日前，中国科协公示了第四届“青年人才托举工程”（2018–2020年度）入选名单，来自全国高校和科研单位的285名青年科技人才拟入选，其中半导体所娄正副研究员榜上有名。

娄正，1987年生，2014年博士毕业于吉林大学，同年入职超晶格实验室沈国震研究员课题组，主要从事基于低维纳米复合材料的柔性电子器件的相关研究，在量子点修饰纳米线提高敏感性能，超薄多功能电子皮肤以及柔性视觉存储等方面取得了创新性的成果。主要成果包括：高性能柔性光电探测器和图像传感器研究，解决了纳米线光电探测器器件相关关键问题，对满足人们多元化的应用需求具有重要的意义；超薄多功能电子皮肤研制，解决了目前电子皮肤无法拉伸、难以大规模制备、受温度干扰严重等问题，成功地实现了对人体生理信号的实时快速监测及不同手势的人机交互；多功能柔性集成传感系统，通过将柔性传感器集成微型电容器，柔性忆阻器等功能单元，解决了传统能源器件与柔性传感器不匹配以及无法存储感知信息等难题，实现了多功能自驱动电子皮肤集成及视觉感知与存储系统集成。基于以上成果，迄今共发表SCI检索论文80余篇，SCI他引2100余次，h因子为29。以第一作者及通讯作者在Adv. Mater., Adv. Funct. Mater., Nano Energy, Small等杂志共发表论文27篇，其中一区文章19篇，IF>10论文8篇，ESI高被引论文3篇。2018年入选RSC“Top 1%高被引中国作者”榜单（Nanoscience类）。作为负责人承担项目4项，同时获得三次省部级奖励，包括北京市科学技术奖二等奖以及中国材料研究学会科学技术奖一等奖等。

据悉，“青年人才托举工程”是由中国科协2015年启动的人才支持项目，旨在帮助青年科技人才在创造力黄金时期做出突出业绩，努力成长为品德优秀、专业能力出类拔萃、社会责任感强、综合素质全面、具有国际视野的学术技术带头人，成为国家主要科技领域高层次领军人和高水平创新团队的重要后备力量。

该人才支持计划主要对32岁以下具有较强创新能力和发展潜力的科技人员采用稳定支持方式，给予每位入选者连续3年的支持，每年15万元。该项目由中国科协所属全国学会选拔、推荐与培养。

半导体所召开2018年第五次党委中心组学习扩大会议



根据年度中心组学习安排，12月21日下午，半导体所党委组织召开了2018年第五次党委中心组学习扩大会议。会议主题为：“传承四十年改革开放精神，加速推进研究所可持续创新能力建设”。北京分院纪检组组长、分党组成员，京区事业单位党委副书记、纪委书记倪宏莅临会议现场指导。半导体所副所长（法定代表人）、党委委员祝宁华，党委书记、副所长冯仁国，副所长、无党派人士杨富华，党委副书记、纪委书记樊志军，副所长、党委委员谭平恒以及其他党委班子成员、职代会常设主席团主席参加了会议。会议由冯仁国主持。

与会同志集体观看了“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”第27讲《促进“一带一路”国际合作》视频资料。冯仁国指出，《三十讲》的出版，为我们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作出了重点梳理、提供了权威解读。学习《三十讲》是一项长期的政治任务，党委中心组将有计划分步骤在学习习近平新时代中国特色社会主义思想原文原著上下功夫，坚持系统全面地学、持续跟进地学，坚持学思用贯通、知信行统一，更好地提高政治理论素质。

随后，冯仁国传达了习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神，简明扼要地介绍了总书记讲话的主要内容及其重大意义。冯仁国指出，40年的历程充分证明，改革促进发展，开放带来进步。我们要学习和继承开拓进取、敢为人先的改革开放精神，加速推进研究所可持续创新能力建设。

党委副书记、纪委书记樊志军传达了中共中国科学院党组《关于认真学习贯彻〈关于深化中央纪委国家监委派驻机构改革的意见〉的通知》精神和要求。她指出，《关于深化中央纪委国家监委派驻机构改革的意见》的出台是通过深化派驻机构改革，延伸中央纪委国家监委监督触角，进一步发挥派驻机构“派”的权威和“驻”的优势，督促党委（党组）担当起政治责任。半导体所纪委将认真学习《深化中央纪委国家监委派驻机构改革的意见》，深化思想认识，提高政治站位和政治觉悟，不断增强“四个意识”，在北京分院纪检组及所党委领导下，继续做好研究所的纪监审工作，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的政治生态。她还解读了《党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》的主要内容及其重大意义。

副所长杨富华作了题为“材料和装备是国家科技强盛之根本”的专题报告，他从分析信息科学技术发展趋势入手，谈了对“中兴事件”的思考，系统分析了半导体所平台建设现状及未来展望。

副所长谭平恒作了关于人才队伍建设专题报告。他系统分析了半导体所人才队伍情况及人才工作的现状及面临的困境，并在此基础上提出了加强人才队伍建设的建议措施。

与会同志围绕会议主题开展了热烈的研讨。祝宁华在发言中谈到，人才是立所之本，兴所之基，我们要秉承事业留人、感情留人的理念，继承敢为人先的改革开放精神，为半导体所的长远发展做出新的贡献。

最后倪宏发表总结讲话。他对半导体所此次党委中心组学习给予了充分的肯定，他认为此次党委中心组学习主题突出，内容详实丰富，达到了进一步统一思想、凝聚共识、提高站位的目的。党委中心组要使学习效果落地生根，推动研究所高质量发展、真正达到率先垂范的示范作用。

冯仁国表示，半导体所党委将把“五个坚决”作为工作目标认真落实：一是坚决把旗帜鲜明讲政治落到实处；二是坚决把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想落到实处；三是坚决把组织建设落到实处；四是坚决把纪律建设落到实处；五是坚决把半导体材料与光电子器件卓越中心建设的各项工作落到实处。



半导体所各党支部集中组织 党建述职考评、组织生活会和民主评议党员工作

根据半导体所党委的部署，所属各党支部于11月-12月集中组织开展了党建述职考评、组织生活会和民主评议党员工作，党支部书记总结工作，党员群策群力，民主评议党员促进学习提高。

各党支部还组织开展了“讲述身边的科学家故事”主题活动，身边的院士、学术带头人、“两弹一星”参与者等成为大家学习的榜样，通过讲述人的讲述勉励党员在新时代自觉弘扬践行爱国奋斗精神，把个人梦融入到中国梦，把家国情怀转化为新时代的奋斗激情，做新时代的奋斗者，勇担民族复兴大任。

支部纪检委员为党员上“廉政党课”，将纪检宣传教育工作延伸到每个党的基层组织、每个党员，防微杜渐，警钟长鸣。



半导体所举办科技体制改革与“放管服”政策讲座



为适应新形势，及时了解和掌握科技体制改革相关政策，进一步规范科研经费管理，11月27日下午，半导体所邀请中科院监督与审计局副局长袁东来所作了题为“对科技体制改革与‘放管服’的思考”的讲座。

袁东谈到，新时期下党和国家将科技创新提到了前所未有的高度，国家创新驱动发展的目标对我院提出了更高的要求。他深入解读了党的十九大对经济社会建设、科技创新、全面从严治党、风险防控、精准扶贫等做出的全面部署，具体介绍了中科院的整体经济运行情况，以及近5年来科研经济业务真实性、合法性、审计实施情况及取得的成效，从改进中央财政科研项目资金管理、完善科研院所差旅会议管理、完善科研仪器设备采购管理等方面对“放管服”政策进行了全面剖析。

祝宁华在总结讲话中谈到，感谢袁东副局长的精彩报告，通过聆听报告让我们更进一步掌握了国家科技体制改革政策，掌握合规与不合规的界限，帮助我们用好每一笔科研经费。

此次讲座是根据2018年度纪监审工作计划举办，旨在进一步提高全所职工对深化科技体制改革的认识，促进科研经费真实合法合规使用，营造风清气正的科研环境，为实现“三个面向”、“四个率先”目标提供坚实保障。

半导体所举行离退休新春团拜会



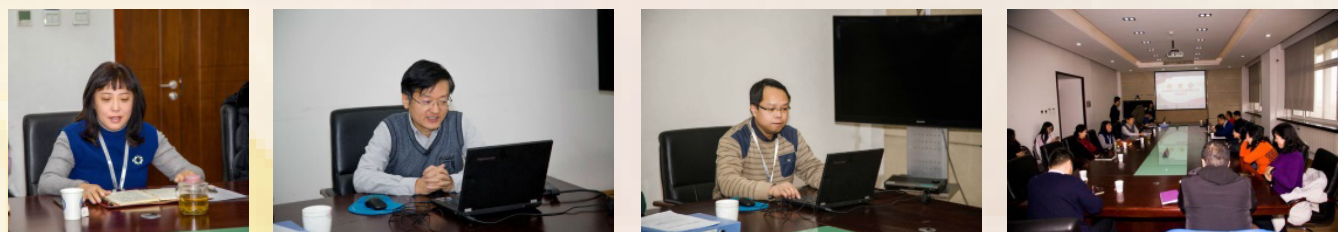
2019半导体所元旦晚会圆满落幕



半导体所2018-2019学年度留学生交流会圆满结束



半导体所召开2018年度群团工作总结交流会



所党委副书记、
纪委书记樊志军讲话

工会主席王军喜
传达重要讲话精神

工会副主席慕东作报告

会议现场